



「次世代パワー半導体 Ga₂O₃ とダイヤモンドの進展」

◇ 日時: 2020 年 9 月 24 日(木) 10:00~17:15

◇ 場所: オンライン開催

近年、SiCよりも大きなバンドギャップを有する α 型および β 型酸化ガリウム(α -, β -Ga₂O₃)やダイヤモンドを用いたパワーデバイスの研究開発が著しく進展しています。今回は、次世代ワイドギャップ半導体の α -Ga₂O₃、 β -Ga₂O₃、ダイヤモンドにフォーカスし、結晶成長、欠陥評価、デバイス作製・特性評価の観点から、専門家の講師の先生方に最新の研究成果についてご講演いただきます。各材料における現状を理解するとともに、各パワーデバイスの特徴について相互に比較し、ワイドギャップ半導体パワーデバイスのさらなる展開について、議論できる場となれば幸いです。※当初予定(3月2日)と同じ講師陣でのオンライン開催となりました。移動不要ですので、是非、多数ご参加下さい。

.....プログラム.....

開会のあいさつ、進め方のご案内、等 10:00~10:10

β -Ga₂O₃ 結晶成長技術の現状 10:10~11:00
倉又 朗人 (ノベルクリスタルテクノロジー)

イオン注入ドーピングプロセスを用いた縦型 β -Ga₂O₃ パワートランジスタ開発 11:00~11:50
東脇 正高 (情報通信研究機構)

休 憩 11:50~13:20

高品質 α -Ga₂O₃ およびその混晶の薄膜成長ならびにデバイス応用 13:20~14:10
藤田 静雄 (京都大学)

ダイヤモンド半導体におけるエピタキシャル成長技術の現状 14:10~15:00
加藤 宙光 (産業技術総合研究所)

休 憩 15:00~15:30

ダイヤモンドパワーデバイスの開発動向 15:30~16:20
梅沢 仁 (産業技術総合研究所)

ダイヤモンド、酸化ガリウムのシンクロトン X 線トポグラフィー評価 16:20~17:10
嘉数 誠 (佐賀大学)

閉会のあいさつ 17:10~17:15

■参加受付: WEB 参加受付システム(ここをクリック*)から 9 月 22 日(火)までに参加登録をお願いします。登録時には禁止事項への同意書が必要となります。なお、当日の資料は PDF 版となります(希望者には冊子版を後日送付)。参加登録後(有料区分の方はお支払完了後)に、参加用 URL ならびに資料のダウンロード法等をご連絡いたします。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai17.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (消費税込) 参加登録後、オンライン決済を行ってください。

先進パワー半導体分科会会員* 2,000 円、分科会学生会員(入会予定者を含む) 無料、一般 4,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

太子 敏則 (信州大学)

TEL: 026-269-5383

e-mail: taishi@shinshu-u.ac.jp

寺地 徳之 (物質・材料研究機構)

TEL: 029-860-4776

e-mail: TERAJI.Tokuyuki@nims.go.jp

佐野 泰久 (大阪大学)

TEL: 06-6879-7284

e-mail: sano@prec.eng.osaka-u.ac.jp

五十嵐 周 (応用物理学会事務局)

TEL: 03-3828-7723

e-mail: igarashi@jsap.or.jp